PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-030784

(43) Date of publication of application: 02.02.1999

(51)Int.CI.

G02F 1/1343

G02F 1/136

(21)Application number: 09-186430

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

11.07.1997

(72)Inventor: ARATANI YOSHIKAZU

HAGEN KRAUSMAN **UCHIUMI YUKA**

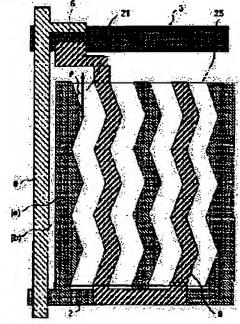
OTA MASUYUKI KONDO KATSUMI **FUNAHATA KAZUYUKI**

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a liquid crystal display device of a multidomain horizontal electrical field method with a high opening ratio by providing the electrode with a structure bent on the substrate surface and making the number of that bent a specific range in one picture element.

SOLUTION: The common electrode 2 and the pixel electrode 9 are each bent, with the number of that bent specified to be three to eleven within one pixel. In addition, the side adjacent to the image signal electrode 8 is linearly formed in the common electrode 2. The rubbing direction 21 for orienting liquid crystal on the boundary and the angle formed by the electrodes 2, 9, i.e., the bent angle θ are identical in all electrodes, with the angle θ set at 15 degrees. With the number of the bent specified to be three or more, a substantial opening ratio can be obtained even if the pixel is quadrisected. Further, with the number of the bent specified eleven or more, the opening ratio becomes 30% or below.



Consequently, by prescribing the number of the bent to be three to eleven, the opening ratio can be improved.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.01.2002

[Date of sending the examiner's decision of

09.09.2003

rejection

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or

application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

3519573

[Date of registration]

06.02.2004

[Number of appeal against examiner's decision 2003-19868

THIS PAGE BLANK (USPTO)

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's 09.10.2003 decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-30784

(43)公開日 平成11年(1999)2月2日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

G02F 1/1343

1/136

500

G02F 1/1343

1/136

500

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

(21)出職番号

特顧平9-186430

(22)出顕日

平成9年(1997)7月11日

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 荒谷 介和

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者 ハーゲン クラウスマン

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者 内海 夕香

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株

式会社日立製作所日立研究所内

(74)代理人 弁理士 高橋 明夫 (外1名)

最終頁に続く

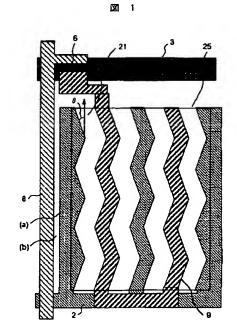
(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】高開口率のマルチドメイン横電界方式の液晶表示装置を提供にある。

【解決手段】一対の基板と、該基板間に挟持された液晶層を有し、前記基板の少なくとも一方には、基板にほぼ平行な電界を液晶層に印加する複数の電極と、該電極の少なくとも一つを保護する保護膜と、該保護膜または電極上に形成された配向膜を有する液晶表示装置において、前記電極が基板面上で折れ曲がった構造を有し、かつ、その形れ曲がりの数が上面素体で3~1.1である液

つ、その折れ曲がりの数が1画素内で3~11である液晶表示装置。



2…共通電機 3…企業信号電振 6…非晶質 S i 験 8 …映像信号電極 9…個素電機 2 i …ラビング方向 2 5…制口部

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の基板と、該基板間に挟持された液 晶層を有し、前記基板の少なくとも一方には、基板にほ ぼ平行な電界を液晶層に印加する複数の電極と、該電極 の少なくとも一つを保護する保護膜と、該保護膜または 電極上に形成された配向膜を有する液晶表示装置におい て、

前記電極が基板面上で折れ曲がった構造を有し、かつ、 その折れ曲がりの数が1画素内で3~11であることを 特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 直線状に形成され映像信号電極と、該映 像信号電極に最も隣合う前記折れ曲がった電極は、映像 信号電極側のみが直線状になるよう形成されている請求 項1に記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記折れ曲がった電極は、その折れ曲が り部において、その角度が異なる部分を2つ以上設け段 階的に折れ曲がっている電極を備えた請求項1に記載の 液晶表示装置。

【請求項4】 一対の基板と、該基板間に挟持された液 晶層を有し、前記基板の少なくとも一方には、基板には 20 れていない。 ば平行な電界を液晶層に印加する複数の電極と、該電極 の少なくとも一つを保護する保護膜と、該保護膜または 電極上に形成された配向膜を有する液晶表示装置におい て、

青. 緑、赤の画素を有し、前記青の画素におけるピーク 透過率波長が450~500nm、緑の画素におけるビ ーク透過率波長が540~560nm、赤の画素におけ るピーク透過率波長が540~600 nmとなるよう液 晶層の厚さが形成され、各画素の電極は基板面上で折れ 曲がった構造を有し、かつ、その折れ曲がりの数が1画 素内で3~11で、前記青の画素における電極の折れ曲 がり角度は、前記縁の画素の電極の折れ曲がり角度より も小さくなるよう形成されていることを特徴とする液晶 表示装置。

【請求項5】 液晶層の厚さと液晶の屈折率異方性の積 で表わされるリターデーションが、青の画素では450 ~500nmの概ね1/2、緑の画素では540~56 0 n mの概ね1/2、赤の画素では540~600 n m の概ね1/2となるよう構成されている請求項4に記載 の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係 り、基板面にほぼ平行な方向に電界を印加して液晶を駆 動する液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の液晶表示装置においては、液晶層 を駆動する電極は2枚の基板上にそれぞれ形成され、対 向配置された透明電極を用いていた。これは液晶に印加 する電界の方向を基板面にほぼ垂直な方向とすることで 50 【0013】上記を解決する本発明の要旨は次のとおり

動作するツイステッドネマチック表示方式に代表され

【0003】一方、液晶に印加する電界の方向を基板面 にほぼ平行にする方式として櫛歯電極対を用いた方式 が、例えば、特公昭63-21907号、USP4,3 45,249号、WO91/10936号、特開平6-222397号および特開平6-160878号等によ り提案されている。

【0004】この場合には電極は必ずしも透明である必 10 要は無く、導電性の高い不透明な金属電極が用いられ る。との液晶に印加する電界の方向を基板面にほぼ平行 な方向とする表示方式(以下、横電界方式と云う)につ いて、折れ曲がった電極を用いてマルチドメインを形成 し、表示面に対し斜め方向から見た場合の色調変化や階 調反転をなくす方法については、S. Aratani et al. Jpn. J. Appl. Phys. 36 (1A/B) L27-29 (1997) に記載されている。

【0005】しかしながら、このような折れ曲がった電 極を用いた場合の高開口率を得る方法については言及さ

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記のように折れ曲が った電極を用いて単純に画素を形成すると、画素そのも のが折れ曲がった構造になる。そのために、直線を表示 した場合に、微小な画素の折れ曲がりが見えて、表示品 質を低下させると云う問題がある。

【0007】そこで、画素は長方形のままとし、電極の み折れ曲がったものを使用して、マルチドメインを形成 することを考えた。実際にそのように設計すると、画素 30 の左右両端にある直線上の映像信号電極の間に、折れ曲 がった共通電極および画素電極を配置することになる。 その場合、遮光しなければならない映像信号電極と隣接 する共通電極 (あるいは画素電極) の間の領域が増える ので、開口率が大幅に低下してしまうと云う問題が生じ た。

【0008】本発明の目的は、上記のこうした課題を解 決し、髙開口率のマルチドメイン横電界方式の液晶表示 装置を提供することにある。

[0009]

40

【課題を解決するための手段】長方形の画素で電極のみ 折れ曲がったものを用いた場合、開口率を低下させる要 因として、下記の3点が挙げられる。

【0010】 の 映像信号電極とそれに隣接する電極と の間に挟まれた領域が広くなる。

【0011】② 映像信号電極に隣接する電極の幅が広

【0012】3 電極の折れ曲がった個所に生ずるディ スクリネーション (液晶が動かない領域) により光が透 過しない部分が生ずる。

3

である。

【0014】(1) 一対の基板と、該基板間に挟持された液晶層を有し、前記基板の少なくとも一方には、基板にほぼ平行な電界を液晶層に印加する複数の電極と、該電極の少なくとも一つを保護する保護膜と、該保護膜または電極上に形成された配向膜を有する液晶表示装置において、前記電極が基板面上で折れ曲がった構造を有し、かつ、その折れ曲がりの数が1画素内で3~11であることを特徴とする液晶表示装置。

【0015】(2) 直線状に形成され映像信号電極 と、該映像信号電極に最も隣合う前記折れ曲がった電極 は、映像信号電極側のみが直線状になるよう形成されている前記の液晶表示装置。

【0016】(3) 前記折れ曲がった電極は、その折れ曲がり部において、その角度が異なる部分を2つ以上設け段階的に折れ曲がっている電極を備えた前記の液晶表示装置。

【0017】前記①の領域を低減すには折れ曲がった電極の曲げる数を増やすことが有効である。電極の折れ曲 ば角度が同じ場合折り曲げの数を増やすと、直線状の映 20 像信号電極との間の領域が小さくなる。

[0018] 実際には折れ曲がり数が3個以上になると 急激に前記のの領域が小さくなり高開口率が得られる。 しかし、逆に折れ曲がり数が多くなると前記ののディス クリネーションによる光の透過しない領域が増え、開口 率が低下してしまう。

【0019】開口率の下限は、ISO9243で定められており30%以上でないといけないとされている。上記規格を満足するには折れ曲がり数は3~11がよい。*

 $T = T_0 \cdot \sin^2 2\phi \cdot \sin^2 ((\pi \cdot d \cdot \Delta n)/\lambda)$

ことで、T。は係数で、主として液晶パネルに使用される偏光板の透過率で決まる数値、φは液晶層の実効的な 光軸と偏光透過軸のなす角度、d は液晶層の厚さ、Δ n は液晶の屈折率異方性、λ は光の波長を表す。

【0026】〔1〕式から分かるように、d・Δn/λが1/2の整数倍になると透過率が最も大きくなる。通常との値が概ね1/2となるように設定して十分な透過率を得るようにする。しかしながら、通常用いられる青、緑、赤の画素を用いた液晶表示装置では、それぞれの画素を最終的に透過する光の波長が異なる。従って、※40

 $E_{c} = \pi / d \cdot \sqrt{(\varepsilon_{o} \cdot \Delta \varepsilon)}$

ここで、d は液晶層の厚さ、 K_z は液晶のツイストの弾性定数、 ϵ_o は真空の誘電率、 $\Delta \epsilon$ は液晶の誘電率の異方性を示す。

【0029】上記〔2〕式から分かるように、液晶層の厚さ d が小さくなるとしきい値電圧は大きくなり、いわゆる駆動電圧が大きくなる。従って、各色の画素の透過率をそれぞれ最大にしようと液晶層の厚さ d を変えると、それぞれの画素の駆動電圧が変化してしまうと云う問題が生じる。

4

* $\{0020\}$ 映像信号電極と最も隣合う折れ曲がった電極の映像信号電極側を直線状に形成(図1(a))すると、映像信号電極8 との間の光が漏れる領域(図1(b))をさらに小さくできる。この領域が小さくなればその部分を遮光するブラックマトリクスの大きさを小さくでき、実質的に開口率を大きくすることができる。 $\{0021\}$ 一画素内の両端の電極の折り曲げを2段階(図6の θ_1 と θ_2)以上にする。特に、前記2の映像信号電極8に隣接する電極ではその幅を小さくできる。これにより開口率を大きくすることができる。

【0022】また、輝度を上げるためには開口率を上げるだけでなく、下記により全体の光透過率を大きくして、輝度向上を図ることができる。

【0023】(4) 青、緑、赤の画素を有し、前記青の画素におけるピーク透過率波長が450~500 n m、緑の画素におけるピーク透過率波長が540~560 n m、赤の画素におけるピーク透過率波長が540~600 n mとなるよう液晶層の厚さが形成され、各画素の電極は基板面上で折れ曲がった構造を有し、かつ、その折れ曲がりの数が1画素内で3~11で、前記青の画素における電極の折れ曲がり角度は、前記緑の画素の電極の折れ曲がり角度よりも小さくなるよう形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【0024】横電界方式はいわゆる複屈折モードを用いているためその透過率Tは、一般に〔1〕式で表すことができる。

[0025]

【数1】

※ d・△n/λ≒1/2になるdは、各画素で異なってしまう。そのため、青、緑、赤のそれぞれの画素の光の透過率を最大にするためには、それぞれの画素の液晶層の厚さdを変える必要がある。しかし、横電界方式の場合、液晶層の厚さdを変えると駆動電圧がそれぞれ変わってしまう。

... (1)

【0027】横電界方式の液晶表示装置のしきい値電圧 Ecは〔2〕式で表される。

[0028]

【数2】

... (2)

【0030】折れ曲がった電極を用いたマルチドメイン 横電界方式の場合には、折れ曲がり角度をそれぞれ変え ることにより駆動電圧を変えることができるため、この 問題を解決することができる。即ち、液晶層の厚さが小 さい画素では折れ曲がり角度を小さくし、液晶層の厚さ が大きい画素では折れ曲がり角度を大きくすることによ り、それぞれの画素の駆動電圧を等しくできる。

[0031]

50 【発明の実施の形態】

〔実施例 1〕図1は本発明の電極を形成した液晶表示 素子の単位画素の模式図である。また、図2は図1の液 晶表示素子の模式断面図である。

【0032】ガラス基板1上にA1からなる共通電極2 および走査信号電極3が形成され、さらにその表面はア ルミナ膜4で被覆されている。また、それらの電極の上 にSiNからなるゲート絶縁膜5が形成され、さらにそ の上に非晶質Si(a-Si)膜6、n型a-Si膜 7、A1/Crからなる映像信号電極8および画素電極 9からなるTFT (Thin Film Transistor) が形成

【0033】さらにその上層には、SiNからなる保護 膜10が形成され、さらにその上層には配向膜11が形 成されている。

【0034】共通電極2は走査信号電極3と平行に配置 されている。また、画素の開口部25は、共通電極2お よび画素電極9によって4分割されている。また、画素 電極9は共通電極2と一部重なり合い、保持容量を形成 している。画素ピッチは横方向が100μm、縦方向が 300μmであり、開口部の大きさは77μm×235 20 できる。 μmである。

【0035】また、開口部25内の電極の幅はいずれも 6 μ m である。開口部25の大きさは、共通電極2と映 像信号電極8の間の光漏れが、上下基板の合わせ位置が 左右に5.5μmずれても、正面から見えないよう決定 した。

【0036】本実施例の特徴は、図1に示すように共通 電極2および画素電極9がそれぞれ折れ曲がっており、 折れ曲がり数が5である。また、共通電極2の映像信号 電極8に隣接する側は直線状に形成されている。界面で 30 の液晶を配向させるためのラビング方向21と、電極 2、9とがなす角度、即ち、折れ曲がり角 θ はいずれの 電極においても等しく、本実施例ではその角θは15度 とした。

【0037】また、折れ曲がり数(開口部内の折れ曲が り部の数)を3以上にすると、画素が4分割でもかなり の開口率を得ることができる。図1のように折れ曲がり 数5の場合は、その開口率は32.5%である。

[0038]折れ曲がり角 θ で折れ曲がり数が1である と映像信号電極8に隣接する共通電極2が非常に大きく なり、開口率が著しく小さくなることが図1から容易に 推測できよう。との場合の開口率は20.5%である、 このように折れ曲がり数を3以上とすることにより、開 口率を向上することができる。

【0039】なお、折れ曲がり数は奇数の方が望まし い。電極を図1のように折り曲げることによるマルチド メインの形成は、横電界方式の色調変化低減を目的とし ている。電極を折り曲げることにより、液晶の向きが反 対称的なドメインをそれぞれ同数形成し、それぞれの色

れ曲がり数が偶数の場合には、液晶の向きが反対称的な ドメインの数が同数とならないため、マルチドメイン形 成による色調変化の低減効果が小さくなってしまう。従 って、折れ曲がり数は奇数である方が望ましい。

【0040】実際の折れ曲がり角 θ は、開口率の点から は小さいことが望ましいが、あまり小さいとディスクリ ネーションが発生する。また、折れ曲がり角hetaが小さい と応答速度が急激に遅くなる。従って、2~30度、望 ましくは5~30度の範囲がよい。

【0041】 (実施例 2) 図3は本発明の電極を形成 10 した他の実施例の液晶表示素子の単位画素の模式図であ る。本実施例では共通電極2の映像信号電極8に隣接す る側が直線ではなく、他の電極と同様に折れ曲がってい る以外は実施例1と同様である。

【0042】実施例1と同様に開口部25の大きさは、 56 μm×235 μmとなる。 この場合の開口率は2 5.4%となり、実施例1の場合に比べて小さい。この 場合、図1のように共通電極2の映像信号電極8に隣接 する側を直線状に形成すると開口率を大きくすることが

【0043】図4は、折れ曲がり数と開口率の関係を示 した図である。画素サイズ等は実施例1と同等であり、 開口部の大きさが77μm×235μmであり、開口部 内の電極の幅は全て6μmとした。

【0044】既述のように映像信号電極8と共通電極2 の間の領域の大きさは、折れ曲がり数に対して逆比例し 小さくなる。従って、折れ曲がり数が1から5まででは 折れ曲がり数の増加に伴い、相対透過率が急激に上昇す る。しかし、折れ曲がり部に発生するディスクリネーシ ョンによる透過率の低下は、折れ曲がり数に比例して大 きくなるので、図4のように折れ曲がり数が6を越える と、逆に相対透過率が低下し、11以上になると開口率 が30%以下になる。従って、折れ曲がり数としては3 ~11が望ましい。

【0045】 [実施例 3] 図5は本発明の電極を形成 した他の実施例の液晶表示素子の単位画素の模式図であ る。本実施例の特徴は共通電極2同志の連結部分が、図 1,3のように画素の下端ではなく、画素中央にある点 にある。

【0046】この場合、中央の電極折れ曲がり部に発生 するディスクリネーションを共通電極で遮光できる。従 って、共通電極2同志の連結部分が画素の下端にある場 合と比較して、高開口率が得られる。

【0047】実施例1と同様な画素サイズの構成した場 合には、本実施例での開口率は33.5%となり、実施 例1より開口率を約1%向上することができる。

【0048】〔実施例 4〕図6は本発明の電極を形成 した他の実施例の液晶表示素子の単位画素の模式図であ る。本実施例の特徴は映像信号電極8に隣接する共通電 調変化を補償し合うことになり色調変化を低減する。折 50 極2の折れ曲がり部の折れ曲がり角を2種(heta、とheta、)

設けたことである。

[0049] こうすることにより、折れ曲がり角が θ_{λ} だけの場合と比較して、電極の幅を小さくすることがで き、これによって開口率を大きくすることができる。

7

【0050】本実施例では θ ,が15度で、 θ ,が3度と した。また、 θ_1 の部分と θ_2 の部分の電極の長さの比を 1:1とした。その他は実施例1と同様である。この場 合、開口率は37.2%となり、実施例1の場合と比較 して大幅に向上することができる。

【0051】〔実施例 5〕図7は本発明の電極を形成 10 した他の実施例の液晶表示素子の単位画素の模式図であ る。また、図8はその液晶表示装置の模式断面図であ る。本実施例の特徴は画素電極9を途中からITOに し、保護膜10の上画素電極9と1T0画素電極22を 配置したことである。

【0052】電極間に横方向の電界を印加した際、画素 電極8の上にも多少横方向の電界が発生する。従って、 該電極上の液晶も開口部と同様に上記電界によって駆動 される。画素電極9を途中からITOにしたことで電極 上の液晶の駆動回転による光の透過を利用でき、全体の 20 光透過率を上げ高輝度化を実現できる。

【0053】〔実施例 6〕図9に本発明の電極を有す る液晶表示素子の基板の模式正面図および模式断面図で ある。本実施例の特徴は、画素Bの液晶層の厚さを画素 Gおよび画素Rの厚さより薄くし、画素Bの電極の折れ 曲がり角 θ を画素G,Bの折れ曲がり角より小さくした ことである。実際には既述のように、各画素を透過する 光の波長に合わせて各画素の透過率が最大になるように するには、このように液晶層の厚さを制御する必要が出 てくる。

【0054】本実施例では、画素Bのリターデーション を240nm、画素G、Rのリターデーションを280 nmとした。前記〔2〕式からも分かるように、液晶層 の厚さが薄くなったことにより、画素Bの駆動電圧は画 素G.Rの駆動電圧より高くなる。そこで図9のように 画素Bの電極の折れ曲がり角θを小さくして、駆動電圧 が低くする。とのように各画素の駆動電圧を同じにする ことができる。

【0055】折れ曲がり角のは、直線状の電極を用いた 際の電極とラビング方向とのなす角度(ラビング角度) に対応する。ラビング角度を小さくすると横電界方式で のしきい値電圧と最大透過率を示す電圧とがそれぞれ小 さくなる。従って、ラビング角度を小さくすると駆動電 圧が小さくなる。

【0056】この現象を利用すると、本実施例のように 各画素の光透過率を最大にでき、かつ、各画素の駆動電 圧を等しくできる。本実施例では画素Bの折れ曲がり角 を8度とし、画素G, Rの折れ曲がり角をそれぞれ15 度とした。これにより、いずれの画素の駆動電圧も、ほ ほ同じにすることができた。このように各画素の駆動電 50 路、19…共通電極駆動回路、20…電源回路およびコ

圧を同じにしたま、で、各画素の透過率を最大にできる ため、液晶表示装置の高輝度化を図ることができる。

【0057】 (実施例 7) 図10は本発明の液晶表示 装置の全体構成図である。

【0058】実施例1の液晶表示素子のTFT基板上に 垂直走査回路17、映像信号駆動回路18、共通電極駆 動回路19を接続し、電源回路およびコントローラ20 から走査信号電圧、映像信号電圧、タイミング信号を供 給し、アクティブマトリクス駆動する。

【0059】実施例1の液晶表示素子では、上下基板の ラビング方向はほぼ平行である。また、図1のラビング 方向21と平行な透過軸を有する偏光板と、垂直な透過 軸を有する偏光板をそれぞれ基板の外側に張り付けて使 用する。このように配置することによってノーマリクロ ーズ特性を得ることができる。

【0060】以上のような構成とすることにより、高輝 度で斜め方向の色調変化および階調反転のない横電界方 式の液晶表示装置を提供できる。

[0061]

【発明の効果】本発明によれば、高輝度で視野角が著し く広く、かつ、斜め方向の色調変化および階調反転のな い液晶表示装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の電極を形成した実施例1の液晶表示素 子の単位画素の模式図である。

【図2】図1の液晶表示素子の模式断面図である。

【図3】本発明の電極を形成した実施例2の液晶表示素 子の単位画素の模式図である。

【図4】本発明の電極の折れ曲がり数と開口率の関係を 30 示した図である。

【図5】本発明の電極を形成した実施例3の液晶表示素 子の単位画素の模式図である。

【図6】本発明の電極を形成した実施例4の液晶表示素 子の単位画素の模式図である。

【図7】本発明の電極を形成した実施例5の液晶表示素 子の単位画素の模式図である。

【図8】図7の液晶表示素子の模式断面図である。

【図9】本発明の電極を有する実施例6の液晶表示素子 の模式正面図および模式断面図である。

【図10】本発明の液晶表示素子を用いた液晶表示装置 40 の全体構成図である。

【符号の説明】

1…ガラス基板、2…共通電極、3…走査信号電極、4 …アルミナ膜、5…ゲート絶縁膜、6…非晶質Si(a -Si) 膜、7…n型a-Si膜、8…映像信号電極、 9…画素電極、10…保護膜、11…配向膜、12…液 晶層、13…対向ガラス基板、14…ブラックマトリッ クス、15…カラーフィルタ、16…カラーフィルタ用 保護膜、17…垂直走査回路、18…映像信号駆動回

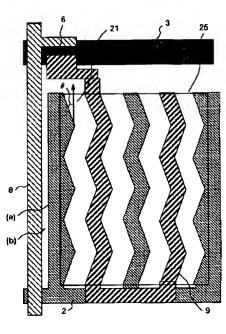
ントローラ、21…ラビング方向、22…ITO画素電* *極、23…表示領域、24…電極、25…開口部。

【図1】

【図2】

図 1

2 2



1---ガラス基板 2---共通電極 3---走査信号電極 4---アルミナ腺 5…ゲート絶線段 6…非晶質Si (a-Si) 膜 7…n型aーSi 膜 8…映像信号電極 9…画業電極 10…保護膜 11…配向膜 12…液晶層 13…対向ガラス基板 14…ブラックマトリックス 15…カラーフィルタ 16…カラーフィルタ用保護膜

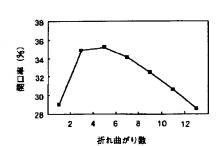
2…共通電極 3…走査信号電極 6…非品質Si膜 8…映像信号電極 9…画素電極 21…ラピング方向 25…開口部

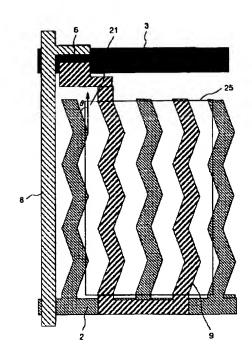
【図3】

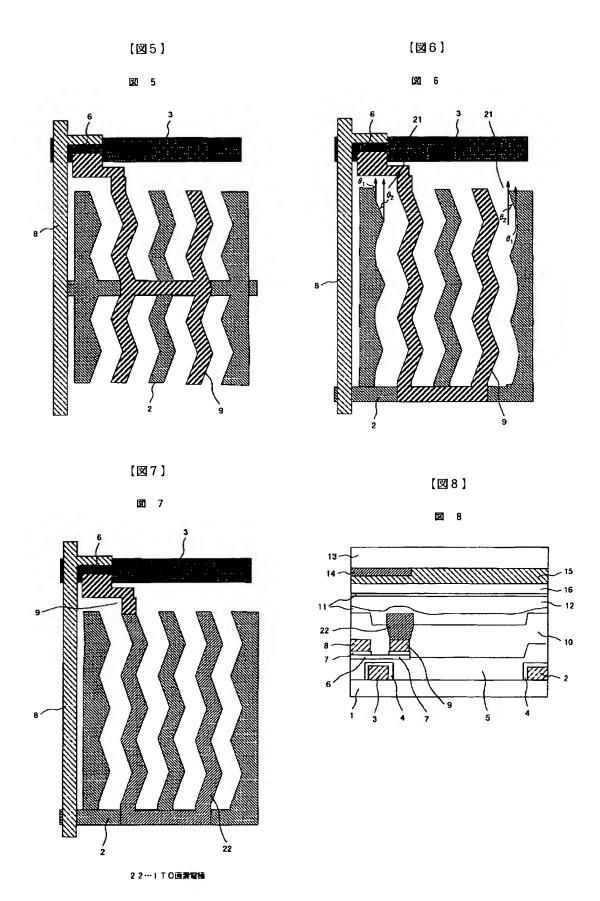
【図4】

図 4

3

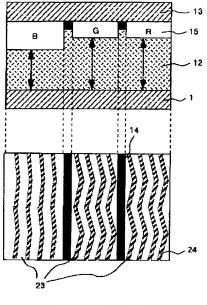






【図9】

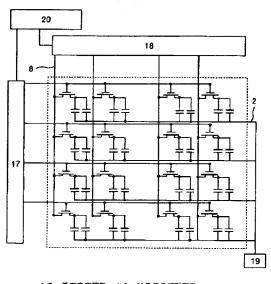
図 9



23…表示領域 24…電極

【図10】

3 10



- 1 7 ···垂直走査団路 1 8 ···映像信号駆動回路 1 9 ···共通電福駅動員路 2 0 ···電源回路およびコントローラ

フロントページの続き

(72)発明者 太田 益幸

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立 製作所電子デバイス事業部内

(72)発明者 近藤 克己

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内

(72)発明者 舟幡 一行

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内